

专利合作条约

发信人：国际检索单位

收信人： 518040 中国广东省深圳市福田区深南大道6021号喜年中心 A座1709-1711 深圳翼盛智成知识产权事务所（普通合伙）	<h2 style="margin: 0;">PCT</h2> <p style="margin: 5px 0;">国际检索单位书面意见</p> <p style="margin: 5px 0;">(PCT细则43之二 . 1)</p>	
国际申请号 PCT/CN2019/070120	国际申请日 (年/月/日) 2019年 1月 2日	优先权日 (年/月/日) 2018年 12月 5日
国际专利分类 (IPC) 或国家分类及IPC H01L 51/56(2006.01) i; H01L 51/52(2006.01) i		申请人 武汉华星光电半导体显示技术有限公司
申请人或代理人的档案号 TP181829PCT		发文日 (年/月/日) 2019年 8月 15日
关于后续行为 见下面第2段		关于后续行为 见下面第2段

1. 本意见包括关于下列各项标明的内容：

<input checked="" type="checkbox"/>	第I栏	意见的基础
<input type="checkbox"/>	第II栏	优先权
<input type="checkbox"/>	第III栏	不做出关于新颖性、创造性和工业实用性的意见
<input type="checkbox"/>	第IV栏	缺乏发明的单一性
<input checked="" type="checkbox"/>	第V栏	按照细则43之二.1(a)(i)关于新颖性、创造性或工业实用性的推断性声明；支持这种声明的引证和解释
<input type="checkbox"/>	第VI栏	某些引用的文件
<input type="checkbox"/>	第VII栏	国际申请中的某些缺陷
<input type="checkbox"/>	第VIII栏	对国际申请的某些意见

2. 后续行为

如果提出初步审查要求书，本次意见将被视为国际初步审查单位 (IPEA) 的一次书面意见，除非申请人选择的国际初步审查单位非本机构，而且所选国际初步审查单位已按照细则66.1之二(b)通知国际局将不考虑国际检索单位的书面意见时例外。

如本书面意见被视为国际初步审查单位的书面意见，则请申请人在自PCT/ISA/220表发文日起3个月或自优先权日起22个月内（以后届满者为准）向国际初步审查单位提交书面答复并提交修改（如适用）。

进一步的选择参见PCT/ISA/220表。

ISA/CN的名称和邮寄地址 中国国家知识产权局 中国北京市海淀区蓟门桥西土城路6号 100088	完成本意见的日期 2019年 8月 12日	受权官员 陈颂杰
传真号 (86-10) 62019451	电话号码 (86-512) 88995748	

第I栏

意见的基础

1. 关于语言，本意见的制定基于：

国际申请提交时使用的语言。

该国际申请的_____语言译文，为了国际检索的目的提供该种语言的译文(细则12.3(a)和23.1(b))。

2. 本意见的制定考虑了本单位许可或被通知的根据细则91所做出的**明显错误更正**（细则 43之二1(a)）。3. 关于在国际申请中公开的任何**核苷酸和/或氨基酸序列**，本意见是基于下列序列列表做出的：a. 作为国际申请的一部分提交的：

附件C/ST.25文本文件形式

纸件或图形文件形式

b. 根据细则13之三.1(a)仅为国际检索目的以附件C/ST.25文本文件形式与国际申请同时提交的：c. 仅为国际检索目的在国际申请日之后提交的：

附件C/ST.25文本文件形式（细则13之三.1(a)）

纸件或图形文件形式（细则13之三.1(b)和行政规程第713段）

4. 另外，在提交/提供了多个版本或副本的序列列表的情况下，提供了关于随后提交的或附加的副本中的信息与申请时提交的作为申请一部分的序列列表的信息相同或未超出申请时提交的申请中的信息范围（如适用）的所需声明。

5. 补充意见：

第V栏 按细则43之二.1(a)(i)关于新颖性、创造性或工业实用性的推测性声明；支持这种声明的引证和解释

1. 声明

新颖性 (N)	权利要求	1-12	是
	权利要求	无	否
创造性 (IS)	权利要求	无	是
	权利要求	1-12	否
工业实用性 (IA)	权利要求	1-12	是
	权利要求	无	否

2. 引证和解释：

[1] D1: CN107507920 A

[2] D1为最接近的现有技术，公开了一种有机电致发光二极管的制作方法（参见说明书第[0004]-[0144]段，附图1-7）：在基底100上形成阳极；在阳极的背离基底100的表面上形成有机发光层5；在有机发光层5的背离阳极的表面上形成阴极6；形成阳极的步骤包括：在基底100上形成第二透明导电层1，利用ITO、IZO、AZO、IGZO、ITZO等透明导电材料制备第二透明导电层1；通过磁控溅射、热蒸发等成膜方式在第二透明导电层1的靠近所述阴极6的表面上形成反射导电层2；通过喷墨打印工艺直接在反射导电层2的靠近阴极6的表面上打印包括纳米银的导电墨水，形成导电墨水3；对反射导电层2的靠近阴极6的表面的导电墨水进行烘烤工艺，使纳米银颗粒融化成半球状的凸起结构31；形成覆盖反射导电层2的靠近阴极6的表面以及多个凸起结构31的第一透明导电层4，利用ITO、IZO、AZO、IGZO、ITZO等具有高功函数的透明导电材料制备第一透明导电层4；其中，第二透明导电层1的厚度为5~15nm，反射导电层2厚度为20nm左右，第一透明导电层4可以为Ag金属，厚度为20~50nm。

[3] 新颖性

[4] 权利要求1、3、10与D1相比，区别特征在于：阵列基板包括设置于衬底基板上的薄膜晶体管阵列。权利要求1、3与D1相比，除上述区别特征外，还包括：第一ITO层、所述反射层、以及所述第二ITO层经过同一道刻蚀工艺形成。权利要求3与D1相比，除上述区别特征外，进一步包括：在第二ITO层上形成图案化的光刻胶。因此，权利要求1、3、10及引用其的权利要求2、4-9、11、12符合PCT条约33(2)的规定。

[5] 创造性

[6] 基于上述区别特征，权利要求1、3、10实际所要解决的技术问题是如何形成晶体管阵列和/或如何刻蚀OLED多层阳极。阵列基板包括设置于衬底基板上的薄膜晶体管阵列以及采用图案化的光刻胶作为掩膜和同一道刻蚀工艺对第一ITO层、反射层、以及第二ITO层进行刻蚀是本领域的公知常识。在D1的基础上结合本领域的公知常识以得到权利要求1、3、10的技术方案对本领域技术人员是显而易见的，权利要求1、3、10不符合PCT条约33(3)的规定。

[7] 权利要求2、4-9、11、12的附加特征未被D1公开，上述权利要求的附加特征是本领域的公知常识，权利要求2、4-9、11、12不符合PCT条约33(3)的规定。

[8] 工业实用性

[9] 权利要求1-12符合PCT条约33(4)的规定。